

## 性能特点

- 工作频段： 8.6GHz~9.5GHz
- 输出功率： 50.5dBm (typ.)
- 功率增益： 8.5dB (typ.)
- 功率附加效率： 45% (typ.)
- 封装形式： 金属封装

## 产品简介

HX8695P100W是一种 GaN 内匹配功率管，用于标准的通信频段，在 50 欧姆系统中提供最佳功率和增益性能。

最大额定值 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

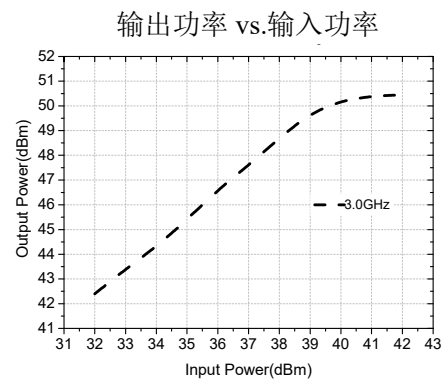
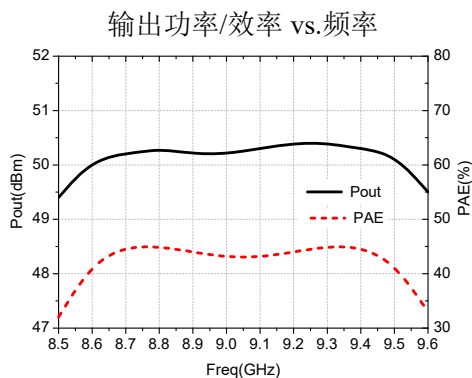
指标	符号	极限值	单位
漏源电压	$V_{DS}$	40	V
栅源电压	$V_{GS}$	-5.0	V
存储温度	$T_{stg}$	-65~+175	$^\circ\text{C}$
沟道温度	$T_{ch}$	200	$^\circ\text{C}$

电参数 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

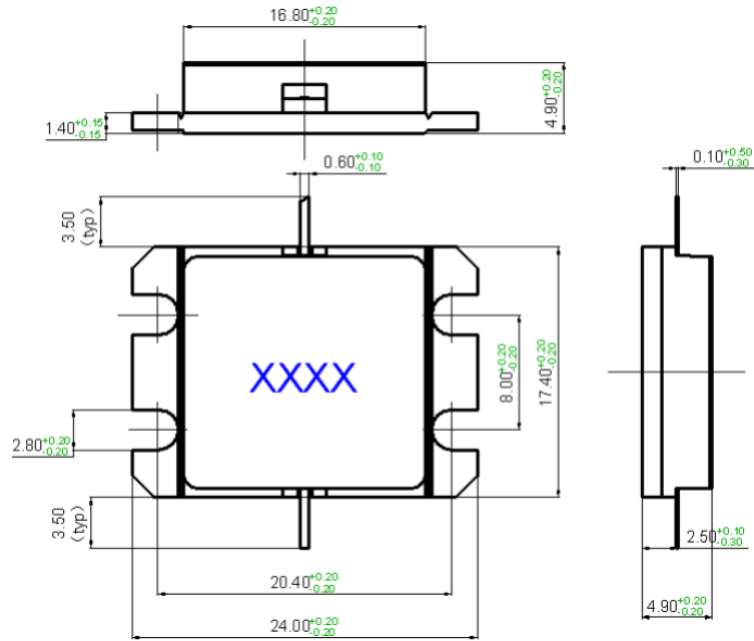
指标	符号	测试条件	极限值			单位
			最小值	典型值	最大值	
夹断电压	$V_p$	$V_{DS}=3\text{V}, I_{DS}\leq 100\text{mA}$	-1.5	-2.2	-3.0	V
栅极截止电流	$I_{GSS}$	$V_{DS}=0\text{V}, V_{GS}=-5\text{V}$	-	-	1	mA
输出功率	$P_{out}$	$V_{DS}=28\text{V}$ $V_{GS}=-1.5\sim-2.2\text{V}$ , $f=8.6\text{GHz}\sim 9.5\text{GHz}$ , 脉 宽 $100\mu\text{s}$ , 占空比10% $Z_S=Z_L=50\Omega$	50	50.5	-	dBm
功率增益	$G_p$		8.0	8.5*	-	dB
功率附加效率	PAE		40	45	-	%
热阻	$R_{th(j-c)}$	Channel to Case 沟道-管壳	-	0.8	1.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$

\*功率增益可根据用户使用条件小范围调节。

## 典型曲线

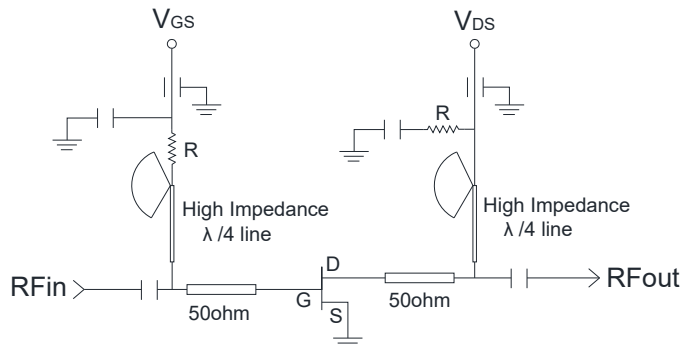


封装尺寸：（单位为 mm）



引出端排列：1-栅极；2-漏极；3-源极

典型使用电路图



注意事项

- 1) 加电时请严格按先加栅压后加漏压的次序操作；
- 2) 使用过程中注意散热，推荐器件工作壳温不超过 75℃，过高会导致器件性能恶化，缩短使用寿命；
- 3) 本产品属于静电敏感器件，储存和使用中注意防静电，仪器、设备等应良好接地；
- 4) 不能触摸器件引线；
- 5) 用图示仪测量直流参数时，必须采取防振荡措施，否则易损坏器件，测试结果也不准确；
- 6) 辐照特性：本器件为辐照不敏感产品；
- 7) 有问题请与供货商联系。



静电敏感性器件  
请注意静电防护